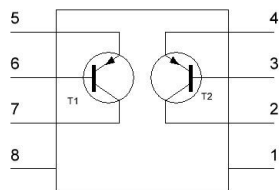
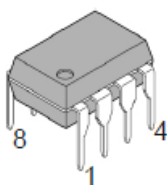


КТС3103А1, КТС3103Б1



Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ +70°C

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	2ТС3103А, КТС3103А, КТС3103А1		2ТС3103Б, КТС3103Б, КТС3103Б1	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ}=15В$), мкА	$I_{КБ0}$		0,2		0,2
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}=5 В$), мкА	$I_{ЭБ0}$		0,5		0,5
Ток утечки между транзисторами ($U_{Т1Т2}=20В$), мкА	$I_{Т1Т20}$		0,1		0,1
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}=1 В$, $I_Э=1 мА$, $t_{и} \leq 2 мс$, $f \leq 50 Гц$)	$h_{21Э1,2}$	40	200	40	200
Отношение статических коэффициентов передачи тока ($U_{КБ}=1 В$, $I_Э=1 мА$, $t_{и} \leq 2 мс$, $f \leq 50 Гц$)	$h_{21Э1} / h_{21Э2}$	0,9		0,8	
Модуль разности прямых напряжений эмиттер - база ($U_{КБ}=5В$, $I_Э=1 мА$), мВ	$ U_{ЭБ1} - U_{ЭБ2} $		3		5
Модуль коэффициентов передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}=1 В$, $I_Э=1 мА$, $f=100 МГц$)	$ h_{21Э1,2} $	6		6	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К=10 мА$, $I_Б=1 мА$), В	$U_{КЭнас}$		0,6		0,6
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ}=5 В$, $I_Э=3 мА$, $f=30 МГц$), пс	τ_K		80		80
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}=5 В$, $f=5-10 МГц$), пФ	C_K		2,5		2,5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ}=0 В$, $f=5-10 МГц$), пФ	$C_Э$		2,5		2,5

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2ТС3103А, КТС3103А, КТС3103А1	2ТС3103Б, КТС3103Б, КТС3103Б1	Примечание
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база (при $R_{ЭБ} \leq 15 кОм$), В	$U_{КБmax}$	15	15	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ0max}$	15	15	
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБmax}$	5	5	
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{Кmax}$	20	20	
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10 мкс$, $Q \geq 2,5$, мА	$I_{Киmax}$	50	50	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (суммарная двух транзисторов), мВт	$P_{Кmax}$	300 120	300 120	
		при $T \leq +55^\circ C$ при $T = +85^\circ C$		
Температура перехода, °C	$T_{п}$	175	175	
Тепловое сопротивление переход-среда, °C/Вт	$R_{Т-с}$	400	400	